

Procedeu de obținere a nanostructurilor de ZnO, care include evaporarea unui amestec de pulberi de ZnO și cărbune și depunerea nanostructurilor pe suporturi cristaline din materiale semiconductoare sau dielectrice, caracterizat prin aceea că evaporarea amestecului este efectuată în mediul ambiant, totodată temperatura sursei fiind menținută între 900...1450 °C, iar gradientul de temperatură dintre sursă și suport este stabilit în mărime de 10...120 °C.